

Mittwoch, 9. November 2022

Session 1: Silizium und Siliziumkarbid	
08:45	Begrüßung der Teilnehmer Engelbert Hopf, Ralf Higgelke, WEKA Fachmedien
09:00	Keynote: Leistungshalbleiter und Leistungselektronik als Schlüsseltechnologie für die Energiewende oder droht die nächste Abhängigkeit! Karl-Heinz Gaubatz, Semikron Danfoss
09:30	Digitales Model eines hocheffizienten Boost-Konverters inkl. der Leiterplatteneffekte Simon Muff, Keysight Technologies
10:15	The Next Generation Silicon Carbide Power Devices Extends the Power Capabilities in 3-phase PFC Salvatore La Mantia, STMicroelectronics
10:45	Kaffeepause und Networking in der Ausstellung
11:15	Wenn die Ladestation zur MW-Applikation wird – Laden von E-Nutzfahrzeugen Dr. Martin Schulz, Littelfuse Europe
11:45	Simplifying Power Designs and Maximizing System Performance with 1700V and 3.3kV SiC Devices Marc Rommerswinkel, Microchip Technology Germany
12:10	Mittagspause und Networking in der Ausstellung
13:30	Keynote: SiC - Von E-Mobility zu diversen anderen leistungselektronischen Anwendungen Tobias Keller, Hitachi Energy
14:00	ROHMs vierte SiC-MOSFET-Generation ist marktreif Kevin Lenz, Rohm Semiconductor
14:30	Neuentwicklungen bei Gießharzen: Silikon, Polyurethan- und Epoxy-Systeme mit hohen Temperaturen und hoher Wärmeleitfähigkeit Jens Bürger, Elantas Europe
15:00	Opportunities of SiC MOSFET Compact Models for Simulating Power Electronic Circuits Dr. Qing Sun, Infineon Technologies
15:30	Kaffeepause und Networking in der Ausstellung
16:15	High-k-Gate-Dielektrika für SiC-Leistungs-MOSFETs und deren Anwendungen Dr. Andrei Mihaila, Hitachi Energy
16:45	Skalierbare Parallelschaltung von IGBT-Modulen für Traktion und Anwendungen der erneuerbaren Energien Patrick Tänzer, Power Integrations
17:15	Next Generation Automotive SiC Power Modules Deliver Maximum Performance for Passenger, Commercial, and Sports Electric Vehicles Alexey Cherkasov, Leapers Semiconductor
17:45	Ende des ersten Konferenztages und Umtrunk Engelbert Hopf, Ralf Higgelke, WEKA Fachmedien

Donnerstag, 10. November 2022

Session 2: Galliumnitrid	
08:45	Begrüßung der Teilnehmer Engelbert Hopf, Ralf Higgelke, WEKA Fachmedien
09:00	Keynote: Enabling a Broader Power Application Domain while Reducing the Carbon Footprint thanks to Wide Bandgap Technologies Sven Reinhardt, STMicroelectronics
09:30	Herausforderungen beim Testing von Wide-Bandgap-Halbleitern meistern – Mit dynamischen Testverfahren zu aussagekräftigen Messergebnissen Frank Heidemann, SET
10:15	Silicon Carbide (SiC) – From challenging material to robust Reliability Filip Geenen, Onsemi
10:45	Kaffeepause und Networking in der Ausstellung
11:30	Akustische Mikroskopie und ihre Anwendung zur Fehleranalyse von Leistungshalbleitern Alexander Walter, HTV Conservation
12:00	GaN usage in QR Flyback for High-efficiency and Compact Power Supplies up to 100W Ester Spitale, Fabio Cacciotto, STMicroelectronics
12:30	Mittagspause und Networking in der Ausstellung
13:45	High Reliability Gallium Nitride Technology for Energy Conversion Dr. Kurt Smith, VisIC Technologies
14:15	Maximizing Performances in AC-DC/DC-DC Power Systems with Mass Manufactured GaN Devices Christiam Gasparini, Innoscience Europe
14:45	Monolithic GaN Power Integration: Advanced Devices and New Applications Michael Basler, Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF
15:05	Kaffeepause und Networking in der Ausstellung
15:30	Advances in GaN-based Motor Drives: How GaN Integrated Circuits are Shaping the Future Marco Palma, EPC – Efficient Power Conversion
16:00	New Generation of GaNFast Half-Bridge Power ICs Enable Complete Integration for Electric Motor Drives Alfred Hesener, Navitas Semiconductor
16:20	Wrap-up und Ende der Veranstaltung Engelbert Hopf, Ralf Higgelke, WEKA Fachmedien

Gold Sponsor



life.augmented

Silber Sponsoren



Bronze Sponsor



Sponsor



Kontakt:

Alexandra Feuerstein
Event Manager
Telefon: +49 89 25556 1372
Email: AFeuerstein@weka-fachmedien.de

powered by



Jetzt anmelden: www.leistungshalbleiter-anwenderforum.de